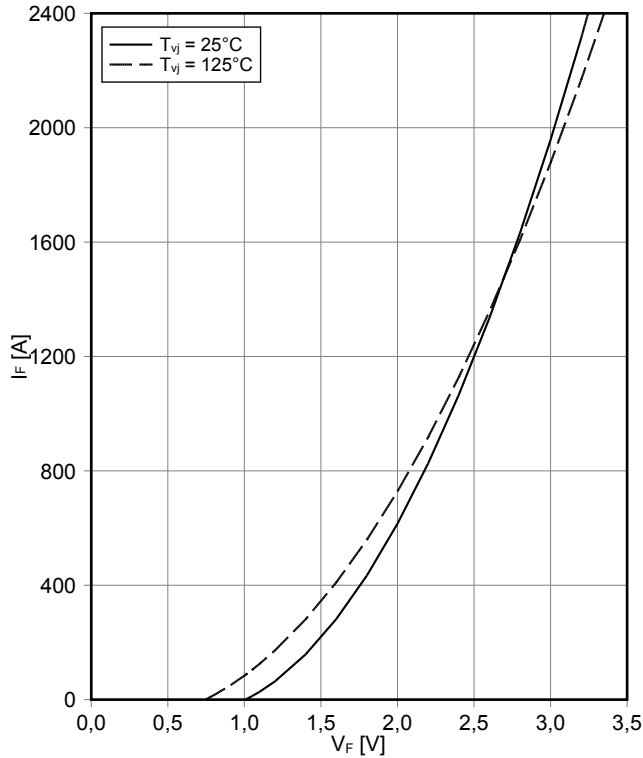


## Modul / Module

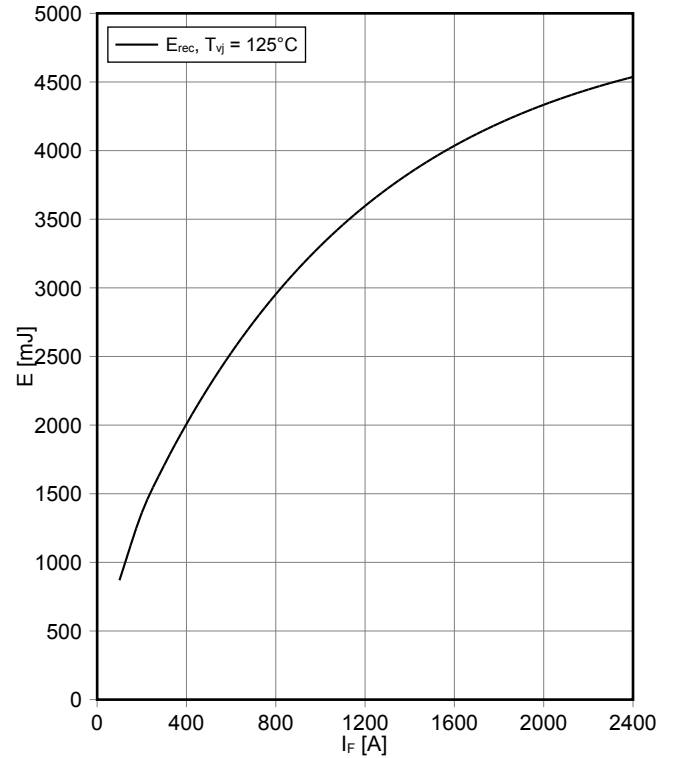
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 10 s	V <sub>ISOL</sub>	10,4		kV
Teilentladungs-Aussetzspannung Partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> ≤ 10 pC	V <sub>ISOL</sub>	3,5		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	3000		V
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			AlSiC		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		AlN		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		56,0 56,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		26,0 26,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 600		
			min.	typ.	max.
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		25	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>AA+CC'</sub>		0,37	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-55		125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	4,25		5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M8 - Mounting according to valid application note	M	8,0	-	10 Nm
Gewicht Weight		G		1000	g

Dynamische Daten gelten in Verbindung mit FZ1200R45KL3\_B5 Modul  
Dynamic Data valid in conjunction with FZ1200R45KL3\_B5 module

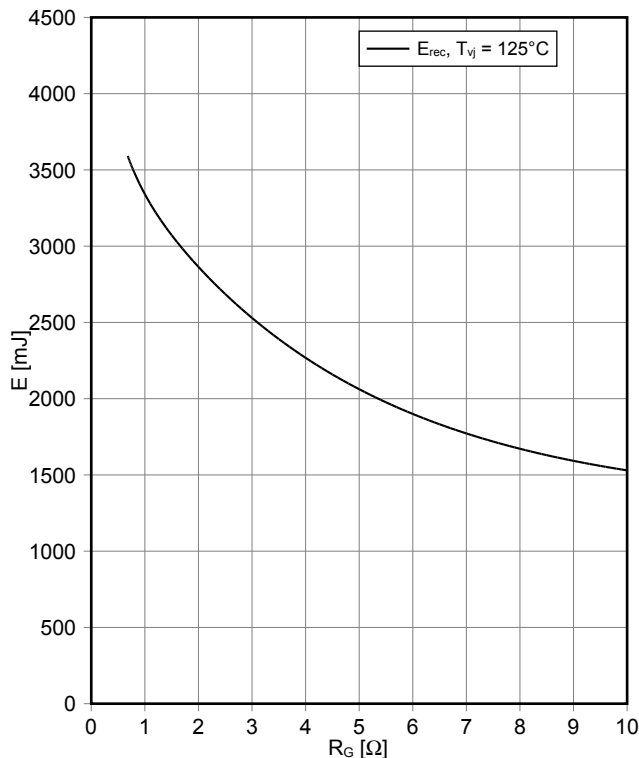
**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**forward characteristic of Diode, Inverter (typical)**  
 $I_F = f(V_F)$



**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $- di_F/dt = 5000A/\mu s, V_{CE} = 2800 V$



**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 1200 A, V_{CE} = 2800 V$



**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**  
**transient thermal impedance Diode, Inverter**  
 $Z_{thJC} = f(t)$

